【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【公開番号】特開2011-14197(P2011-14197A)
【公開日】平成23年1月20日(2011.1.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-003
【出願番号】特願2009-157696(P2009-157696)
【国際特許分類】
Ｇ１１Ｃ　16/06　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ１１Ｃ　17/00　　６３２Ｃ
Ｇ１１Ｃ　17/00　　６３２Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月20日(2012.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
出力が第１ノードに接続され、テスト期間の開始後に昇圧動作を開始するチャージポンプ回路と、
前記テスト期間中に負荷電流を前記第１ノードに供給し、前記テスト期間の終了後に前記第１ノードへの前記負荷電流の供給を停止する負荷電流印加回路と、
ここで、前記第１ノードの電圧は書き込み電圧であり、
メモリセルを有し、前記テスト期間中に前記メモリセルへの前記書き込み電圧の印加を停止し、前記テスト期間の終了後に前記書き込み電圧を前記メモリセルに印加する記憶回路と、
前記書き込み電圧と所定の電圧との比較を行い、前記書き込み電圧が前記所定の電圧に達しているか否かを判定する高電圧検出部と
を備え、
前記テスト期間終了時に前記書き込み電圧が前記所定の電圧に達していない場合、前記高電圧検出部は、ディスエーブル信号を活性化し、
前記ディスエーブル信号が活性化された場合、前記チャージポンプ回路は前記昇圧動作を停止し、それ以外の場合、前記チャージポンプ回路は前記昇圧動作を継続する
半導体装置。